

Сведения о ведущей организации
по диссертационной работе Пудикова Дмитрия Александровича
на тему «**Особенности синтеза и электронной структуры графена на
подложках на основе d- и f- металлов**»
представленной на соискание ученой степени кандидата физико-
математических наук
по специальности 01.04.07 – физика конденсированного состояния

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова Сибирского отделения Российской академии наук
Сокращенное наименование организации в соответствии с уставом	ИФП СО РАН
Почтовый индекс, адрес организации	630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева, д. 13
Веб-сайт	http://www.isp.nsc.ru
Телефон	(388) 330-90-55
Адрес электронной почты	ifp@isp.nsc.ru
Список основных публикаций работников структурного подразделения, в котором будет готовиться отзыв, по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fluorinated graphene dielectric films obtained from functionalized graphene suspension: preparation and properties, Nebogatikova N.A., Antonova I.V., Prinz V.Y., Vdovin V.I., Zakirov E.R., Kesler V.G., Kurkina I.I., Aleksandrov G.N., Timofeev V.B., Smagulova S.A. <i>Physical Chemistry Chemical Physics</i>. 2015. T. 17. № 20. С. 13257-13266. 2. Graphene quantum dots in fluorographene matrix formed by means of chemical functionalization, Nebogatikova N.A., Antonova I.V., Prinz V.Ya., Timofeev V.B., Smagulova S.A. <i>Carbon</i>. 2014. T. 77. С. 1095-1103. 3. Functionalization of graphene and few-layer graphene with aqueous solution of hydrofluoric acid, Nebogatikova N.A., Antonova I.V., Volodin V.A., Prinz V.Y. <i>Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures</i>. 2013. T. 52. С. 106-111. 4. Signatures of dirac fermion-mediated magnetic order, Sessi P., Reis F., Bathon T., Bode M., Kokh K.A., Tereshchenko O.E. <i>Nature Communications</i>.

	<p>2014. Т. 5. С. 5349.</p> <p>5. Сравнение разных способов переноса графена и мультиграфена, выращенных методом химического газофазного осаждения, на изолирующую подложку SiO₂/Si, Антонова И.В., Голод С.В., Соотс Р.А., Комонов А.И., Селезнев В.А., Сергеев М.А., Володин В.А., Принц В.Я. Физика и техника полупроводников. 2014. Т. 48. № 6. С. 827-832.</p> <p>6. Функционализация пленок графена и мультиграфена в водном растворе плавиковой кислоты, Небогатикова Н.А., Антонова И.В., Принц В.Я., Володин В.А., Зацепин Д.А., Курмаев Э.З., Жидков И.С., Чолах С.О. Российские нанотехнологии. 2014. Т. 9. № 1-2. С. 59-65.</p> <p>7. Probing the electronic properties of individual MnPc molecules coupled to topological states, Sessi P., Bathon T., Bode M., Kokh K.A., Tereshchenko O.E. Nano Letters. 2014. Т. 14. № 9. С. 5092-5096.</p> <p>8. Resistive switching effect and traps in partially fluorinated graphene films, Kurkina I.I., Kapitonov A.N., Smagulova S.A., Antonova I.V., Nebogatikova N.A. Journal of Physics D: Applied Physics. 2016. Т. 49. № 9. С. 095303.</p> <p>9. Spin-texture inversion in the giant-Rashba semiconductor BiTeI, Maass H., Bentmann H., Seibel C., Peixoto T.R.F., Reinert F., Tusche C., Kirschner J., Ereemeev S.V., Chulkov E.V., Tereshchenko O.E., Kokh K.A. Nature Communications. 2016. Т. 7. С. 11621.</p> <p>10. Vertical heterostructures based on graphene and other 2d materials, Antonova I.V. Semiconductors. 2016. Т. 50. № 1. С. 66-82.</p> <p>11. Self-organized arrays of graphene and few-layer graphene quantum dots in fluorographene matrix: charge transient spectroscopy, Antonova I.V., Nebogatikova N.A., Prinz V.Y. Applied Physics Letters. 2014. Т. 104. № 19. С. 193108.</p> <p>12. Тонкие частично восстановленные оксид-графеновые пленки: структурные, оптические и электрические свойства, Александров Г.Н.,</p>
--	--

	<p>Смагулова С.А., Капитонов А.Н., Васильева Ф.Д., Куркина И.И., Винокуров П.В., Тимофеев В.Б., Антонова И.В. Российские нанотехнологии. 2014. Т. 9. № 7-8. С. 19-23.</p> <p>13. Films fabricated from partially fluorinated graphene suspension: structural, electronic properties and negative differential resistance, Antonova I.V., Nebogatikova N.A., Komonov A.I., Kurkina I.I., Smagulova S.A. Nanotechnology. 2017. Т. 28. № 7. С. 074001.</p> <p>14. Tuning the dirac point position in Bi₂Se₃ (0001) via surface carbon doping, Roy S., Meyerheim H.L., Ernst A., Mohseni K., Tusche C., Vergniory M.G., Menshchikova T.V., Otrokov M.M., Kirschner J., Chulkov E.V., Ryabishchenkova A.G., Aliev Z.S., Babanly M.B., Kokh K.A., Tereshchenko O.E., Schneider J. Physical Review Letters. 2014. Т. 113. № 11. С. 116802.</p> <p>15. Fluorinated graphene films with graphene quantum dots for electronic applications, Antonova I.V., Nebogatikova N.A., Prinz V.Y. Journal of Applied Physics. 2016. Т. 119. № 22. С. 224302.</p>
--	---

Верно

Руководитель организации

Фамилия И.О.

« ____ » _____ 2018 г.

М.П.